
	<h2>SI7758DP-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7758DP-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7758DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 6205 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI7758DP-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	6205 pcs Stock
Serie	SkyFET®, TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	6.25W (Ta), 104W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.9 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.7V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	160nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7150pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI7758DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7758DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7758DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7758DP-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7774DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7748DP-T1-E3</b> VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p><b>SI7772DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 35.6A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7748DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8</p>
 <p><b>SI7772DP-T1-E3</b> VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>	 <p><b>SI7748DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7772DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 35.6A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7758DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI7716ADN-T1-GE3	 SI7716ADN-T1-GE3	 SI7716ADN-T1-GE3	 SI7716DN-T1-GE3	 SI7720DN-T1-E3
 SI7720DN-T1-GE3	 SI7720DN-T1-GE3	 SI7726DN	 SI7726DN-T1-E3	 SI7726DN-T1-GE3
 SI7726DN-T1-GE3	 SI7732DP-T1-GE3	 SI7738DP	 SI7738DP-T1-3	 SI7738DP-T1-E3
 SI7738DP-T1-E3	 SI7738DP-T1-GE3	 SI7738DP-T1-GE3	 SI7742DP-T1-E3	 SI7742DP-T1-GE3
 SI7742DP-T1-GE3	 SI7748DP-T1-GE3	 SI7748DP-T1-GE3	 SI7758DP	 SI7758DP-T1-GE3
 SI7772DP-T1-GE3	 SI7772DP-T1-GE3	 SI7774DP-T1-GE3	 SI7774DP-T1-GE3	 SI7784DP-T1-GE3
 SI7784DP-T1-GE3	 SI7788DP-T1-GE3	 SI7788DP-T1-GE3	 SI7790DP-T1-E3	 SI7790DP-T1-GE3
 SI7790DP-T1-GE3	 SI7792DP-T1-GE3	 SI7792DP-T1-GE3	 SI7794DP-T1-GE3	 SI7794DP-T1-GE3
 SI7798DP-T1-GE3	 SI7804DN	 SI7804DN-T1-E3	 SI7804DN-T1-E3	 SI7806ADN
 SI7806ADN-T1-E3	 SI7806ADN-T1-E3	 SI7806ADN-T1-E3-PBF	 SI7806ADN-T1-GE3	 SI7806ADN-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited